## 电力电子变压器公共冗余结构及容错控制策略

韩杰祥,张 哲,徐可寒,尹项根

(华中科技大学 强电磁工程与新技术国家重点实验室,湖北 武汉 430074)

摘要:电力电子变压器(PET)包含大量电力电子器件,其子模块故障率相对较高,严重影响了供电可靠性。 为提高级联H桥型PET的可靠性及容错能力,针对级联H桥的结构及运行特点,提出了一种双子模块公共冗 余结构。该结构通过双向开关切换阵列灵活切换2个冗余子模块之间的连接方式,能够在PET内部任意单 子模块和双子模块故障情况下实现备用功能。基于该新型冗余结构,提出相应的容错控制策略及运行模式 切换逻辑,并对比了PET采用不同冗余结构时的运行可靠性和制造成本。

关键词:电力电子变压器;级联H桥;冗余结构;容错控制;可靠性 中图分类号:TM 46

文献标志码:A

DOI:10.16081/j.epae.202112016

#### 0 引言

近年来,交直流混合配电网因其良好的分布 式能源消纳能力和直流负荷匹配性能而受到广 泛关注<sup>[1]</sup>。电力电子变压器(PET)是交直流混合配 电网中的关键互联设备。与传统工频变压器相比, PET能有效减小设备体积和重量,并具备电能变换、 交直流互联、潮流控制、无功补偿、电能质量调节等 功能<sup>[2-5]</sup>。但是,由于PET采用了大量电力电子器 件,其内部故障概率相对较高<sup>[6]</sup>。PET子模块(SM) 故障不但会威胁其自身安全,而且会对交直流混合 配电网造成谐波污染和功率振荡,严重劣化电能质 量,影响电网运行稳定性与供电可靠性。

冗余结构设计和容错控制策略能够在子模块故 障期间维持PET可靠运行,是突破PET脆弱性瓶颈、 更好满足工程化应用要求的重要措施。PET根据结 构特点,可以划分为基于模块化多电平换流器(MMC) 和级联H桥(CHB)这2种基本结构类型<sup>[7]</sup>。MMC型 PET具备中压直流母线,主要用于构建中压直流配 电网,其子模块结构简单,实现全局冗余热备用运行 时设备利用率高,成本增加不明显<sup>[8]</sup>。CHB型PET 直接面向用户,级联子模块数较少,子模块故障将造 成PET结构严重不对称,极大劣化整体运行性能。 另外,CHB型PET的子模块构造复杂,采用分相冗余 设计成本高,且冗余模块利用率低。因此,如何通过 合理的冗余结构设计和容错控制提高 CHB 型 PET 的可靠性受到了更多关注。文献[9-10]研究了CHB 子模块故障造成三相桥臂结构不对称时的容错控制 策略,但是三相桥臂需按照分相冗余设计,增加了设 备制造成本。文献[11]提出了单相 CHB型 PET 的

收稿日期:2021-02-26;修回日期:2021-10-20

基金项目:国家自然科学基金资助项目(51877089)

Project supported by the National Natural Science Foundation of China(51877089)

冗余结构和容错控制策略,但是将该结构拓展应用 于三相PET时,也相当于分相冗余设计,无法满足经 济性要求。文献[6,12]提出了单子模块公共冗余结 构及容错控制策略,但是该结构仅能应对单子模块 故障,容错能力有限。文献[13]将单子模块公共冗 余结构用于CHB型PET,但是冗余子模块运行于冷 备用状态,在切换过程中可能产生较大的暂态冲击。 文献[14]针对CHB型PET,提出单子模块和双子模 块2种冗余结构,但是冗余子模块与主电路子模块 在前级变换器拓扑结构方面存在差异,冗余模块切 换操作较复杂,且不利于设备制造和故障更换。

针对 CHB 型 PET 在冗余结构设计和容错控制 策略研究中存在的不足,本文提出一种双子模块公 共冗余结构及相应的容错控制策略,并从可靠性和 经济性角度,与采用其他冗余结构的PET进行对比 分析。本文所提冗余结构在PET发生任意单子模块 故障和双子模块故障情况下均可实现备用功能。在 控制成本的前提下,冗余子模块利用率和PET运行 可靠性得到显著提高。最后,通过仿真实验验证了 该冗余结构和容错控制策略的正确性和有效性。

#### 1 CHB型PET基本原理

CHB型PET拓扑结构见图1。图中,L。为滤波 电感; SM<sub>a</sub>, SM<sub>b</sub>和 SM<sub>a</sub>(*j*=1,2,…,*N*)分别为 A相、B 相和C相的第j个子模块,N为各相级联子模块数。 PET交流侧采用星形连接的CHB结构, 直流侧三相 子模块统一并联形成直流端口。图2为PET子模块 拓扑结构。图中,子模块旁路开关可用于旁路故障 子模块;前级H桥(HB)可实现双向AC/DC变换;中 间级双有源桥(DAB)采用谐振型双向 DC / DC 变换 器,其双侧HB通过高频变压器(HFT)互联,将直流电 压调制成高频方波,经谐振环节实现功率传递<sup>[15]</sup>。

PET一般采用双闭环控制,根据不同应用需求, 采用有功/电压外环,工作于定功率或定电压2种



Fig.2 Topology of PET's SM

控制模式,实现交直流电网之间的潮流控制或直流 配电网电压调节<sup>[16]</sup>。在2种控制模式下,PET均可 实现功率双向流动,根据交直流配电网功率供求状 况进行快速灵活调节。电流内环通过前馈控制实现 *dq*解耦,给定调制电压指令值。

#### 2 公共冗余结构及容错控制策略

冗余结构设计是应对PET子模块故障的有效措施,但是单子模块公共冗余结构容错能力有限,分相 冗余结构制造成本过高。本文从兼顾设备可靠性和 经济性的角度,提出双子模块公共冗余结构及相应 的容错控制策略。

#### 2.1 拓扑结构设计

100

变压器有载调压的无触点连接方式对冗余结构 设计具有一定的参考作用。有载调压利用电力电子 开关实现调压绕组的投切,从而灵活调节变压器有 效匝数<sup>[17]</sup>。然而,有载调压系统的各相分接头连接 开关需独立设计,调压绕组无需在三相之间进行切 换;在各相绕组内部,不同调压绕组的接入方式也相 对固定。与采用有载调压的分接头连接方式相比, 冗余结构设计的难点在于冗余子模块在三相之间公 共备用功能的实现,以及各冗余子模块之间连接方 式的灵活变换。

利用公共冗余结构实现任意单子模块和双子模 块故障情况下的备用功能,需要解决以下关键问题: ①单子模块故障时,实现冗余子模块在各相间的公 共备用功能;②同相双子模块故障时,实现2个冗余 子模块的串联备用功能;③异相双子模块故障时,实 现2个冗余子模块的分相备用功能;④控制灵活方 便,运行稳定可靠,易于更换维修。 为此,本文提出一种双子模块公共冗余拓扑结构,如图3所示。图中,RM<sub>1</sub>和RM<sub>2</sub>为冗余子模块,其 结构与图2所示的PET主电路子模块拓扑结构相同, 能够在容错运行期间保证PET三相级联结构对称, 以简化控制策略,且易于冗余模块的制造和更换。



## 图3 双子模块公共冗余拓扑结构

Fig.3 Topology of dual-SM communal redundant

RM<sub>1</sub>和 RM<sub>2</sub>的投退及其在三相之间的切换通 过图 3 中的开关组(SU)实现。SU<sub>a</sub>、SU<sub>b</sub>和SU<sub>c</sub>分别为 A 相、B 相和C 相开关组。每个开关组包含 3 个可控 双向开关(BS),即G<sub>x0</sub>、G<sub>x1</sub>和G<sub>x2</sub>(x=a,b,c)。这 3 个 BS采用星形连接,其公共连接点接于 PET 三相级联 桥臂,其他 3 个端口分别接于 RM<sub>1</sub>、RM<sub>2</sub>和中性点。 图 3 中,G<sub>a0</sub>、G<sub>b0</sub>和G<sub>c0</sub>为各相中性点连接控制开关,可 用于调节冗余子模块的投退;G<sub>a1</sub>、G<sub>b1</sub>和G<sub>c1</sub>为 RM<sub>1</sub>投 入各相的控制开关,G<sub>a2</sub>、G<sub>b2</sub>和G<sub>c2</sub>为 RM<sub>2</sub>投入各相的 控制开关,控制开关能够灵活调节冗余子模块投入 相应级联桥臂,实现冗余模块的公共备用功能。

2个冗余子模块连接方式的切换通过图3中的 SU<sub>12</sub>控制。其中,G<sub>20</sub>为RM<sub>2</sub>中性点连接控制开关,控 制RM<sub>2</sub>独立投入级联桥臂,实现双子模块的分相备 用功能;G<sub>12</sub>为RM<sub>1</sub>和RM<sub>2</sub>的串联控制开关,实现RM<sub>1</sub> 和RM<sub>2</sub>的串联备用功能。

需要指出的是,图3中的冗余结构具有良好的可拓展性。以上述设计原则为指导,可以得到多子模块冗余结构如附录A图A1所示,图中包含q个冗余子模块。对于双子模块冗余的情况,即只存在RM<sub>1</sub>和RM<sub>2</sub>,图A1与图3中的结构相同。当冗余结构拓展到n个冗余子模块时,只需要增加子模块投入开关G<sub>aq</sub>,G<sub>bq</sub>和G<sub>cq</sub>,同时,在RM<sub>q</sub>和RM<sub>q-1</sub>之间增加中性点连接控制开关G<sub>qo</sub>以及串联控制开关G<sub>q-1,q</sub>。

鉴于3个及以上子模块同时发生故障的概率较低,从兼顾设备成本和运行可靠性角度,本文重点以 双子模块公共冗余结构为例进行研究,相关结论同 样可拓展应用于多子模块冗余结构。采用图3所示 双子模块公共冗余结构的PET拓扑结构见图4。图 中,冗余模块交流端口X<sub>1</sub>、Y<sub>1</sub>和Z<sub>1</sub>分别接入PET三相 桥臂,冗余模块直流端口与PET直流端口并联。

冷备用子模块在投入运行过程中存在软启动、 暂态过流等问题。此外,冗余子模块因其公共备用



#### 图4 双子模块公共冗余 PET 拓扑结构

Fig.4 Topology of dual-SM communal redundant PET

功能而不能直接投入主电路以热备用状态运行。为此,在PET正常运行时,RM<sub>1</sub>和RM<sub>2</sub>的前级HB闭锁, DAB正常触发,将其电容电压维持在额定值附近。 因此,当冗余子模块投入主回路并收到HB触发信 号时,可迅速进入工作状态,从而避免运行模式切换 过程中的暂态冲击。

#### 2.2 冗余结构工作模式控制

通过调节图3所示的双子模块公共冗余结构中 BS的状态,可控制其工作于正常运行模式、单子模 块投入模式、双子模块同相串联投入模式和双子模 块分相投入模式这4种模式。

1)模式1:正常运行模式。

当PET 三相主电路子模块正常运行时,触发三 相中性点控制开关 $G_{ao}$ 、 $G_{bo}$ 和 $G_{co}$ ,为三相级联桥臂提 供中性点,其余 BS断开。BS状态如附录A表A1中 S<sub>1</sub>对应的状态所示。表中,"1"表示开关导通,"0"表 示开关断开。当中性点控制开关发生故障时,亦可 触发 $G_{a1}$ 、 $G_{b1}$ 、 $G_{c1}$ 或 $G_{a2}$ 、 $G_{b2}$ 、 $G_{c2}$ ,以图3中 $o_2$ 或 $o_3$ 为中 性点,从而提高可靠性,相应的BS状态如表A1中S<sub>2</sub> 和S<sub>3</sub>对应的状态所示。

2)模式2:单子模块投入模式。

PET某一相单个子模块发生故障情况下,应隔 离故障子模块并投入冗余子模块,维持PET整体系 统可靠运行。单子模块投入运行模式下,需闭合 RM<sub>1</sub>投入控制开关,并断开故障相中性点连接控制 开关。以A相为例,闭合G<sub>a1</sub>,断开G<sub>a0</sub>,将RM<sub>1</sub>投入A 相桥臂,BS状态如表A1中S<sub>4</sub>对应的状态所示。在 RM<sub>1</sub>故障情况下,亦可将RM<sub>2</sub>投入A相,作为后备, 以提高运行可靠性。S<sub>4</sub>的后备方案所对应的BS状 态如表A1中S<sub>5</sub>—S<sub>8</sub>对应的状态所示。

3)模式3:双子模块同相串联投入模式。

当某一相发生双子模块故障时,需要将2个冗余子模块串联投入故障相。闭合RM<sub>2</sub>投入控制开关和子模块串联控制开关,断开故障相中性点连接控制开关,即可运行于双子模块同相串联投入模式。以A相为例,闭合G<sub>22</sub>和G<sub>12</sub>,断开G<sub>20</sub>,则RM<sub>1</sub>和RM<sub>2</sub>

串联投入A相桥臂,BS状态如表A1中S。对应的状态 所示。该状态下BS发生故障时,可由表A1中S<sub>10</sub>对 应的状态作为后备。

4)模式4:双子模块分相投入模式。

PET不同相的子模块发生故障时,需要将RM<sub>1</sub> 和RM<sub>2</sub>分别投入故障子模块所在相。在双子模块分 相投入模式下,应闭合其中一相的RM<sub>1</sub>投入控制开 关,并闭合另一相的RM<sub>2</sub>投入控制开关及中性点连 接控制开关G<sub>20</sub>,然后断开2个故障相的中性点控制 开关。以A相和B相子模块故障为例,闭合G<sub>a1</sub>、G<sub>b2</sub> 和G<sub>20</sub>,断开G<sub>a0</sub>和G<sub>b0</sub>,则RM<sub>1</sub>和RM<sub>2</sub>分别投入A相和 B相桥臂,BS状态如表A1中S<sub>11</sub>对应的状态所示。 S<sub>12</sub>对应的状态为S<sub>11</sub>开关组故障下的后备状态。

以表A1中4种工作模式的S<sub>1</sub>、S<sub>4</sub>、S<sub>9</sub>和S<sub>11</sub>对应的 主工作状态为例,其工作电路见附录A图A2。由图 可见,双子模块公共冗余结构能够在任意单子模块 和双子模块发生故障时实现公共备用和灵活投切。

#### 2.3 容错控制策略

PET故障子模块的检测与定位是容错控制的前提,目前已有研究学者开展了较全面的研究<sup>[18-19]</sup>。 故障子模块定位后,首先闭合故障子模块旁路开关 并闭锁DAB,将故障子模块从系统中隔离。然后,结 合冗余结构的运行状态,进行运行模式切换及控制。

1)容错控制流程。

双子模块公共冗余型PET的容错控制流程如附 录A图A3所示。PET的工作状态正常时,冗余结构 中性点连接开关导通,其他开关断开,运行于正常模 式;检测到某个子模块故障时,根据故障定位结果, 导通故障相RM<sub>1</sub>投入控制开关,并断开故障子模块 所在相的中性点连接控制开关,冗余结构从正常运 行模式切换至单子模块投入模式运行。

模式切换开关控制不当可能会引起过电压。以 A相为例,PET的单相数学模型为:

$$u_{\rm sa} - \sum u_{\rm ai} = L_{\rm m} {\rm d}i_{\rm a}/{\rm d}t \tag{1}$$

式中: $u_{aa}$ 为系统电压; $u_{aj}$ 为PET的A相第j个子模块的输出电压; $i_{a}$ 为A相电流。

在模式切换过程中,如果首先断开中性点控制 开关,则电流通路将被截断。由式(1)可知,此时电 感可能产生过电压。因此,BS需要遵循一定的开关 顺序,即冗余子模块投入BS首先导通,然后将待关 断的 BS断开。此时,已经闭合的 BS就能够和冗余 子模块的续流二极管一起提供续流通路,以子模块 电容构成吸收电路,避免回路电感产生过电压。切 换完成后,触发冗余子模块,进入正常工作状态。以 上述 RM<sub>1</sub>投入过程为例,其切换过程及续流通路如 附录 A 图 A4 所示。

在单子模块投入工作模式下,如果PET子模块 再次发生故障,则冗余结构切换至双子模块投入模 式。如果故障子模块与首次发生故障的子模块同 相,则冗余结构切换至双子模块同相串联投入模式。 此时,应导通故障相RM<sub>2</sub>控制投入开关和子模块串联 控制开关,关断故障相RM<sub>1</sub>投入控制开关,在RM<sub>1</sub>投 入运行的基础上,将RM<sub>2</sub>串入故障桥臂。如果故障 子模块与首次发生故障的子模块异相,则冗余结构 切换至双子模块分相投入模式。此时,应导通RM<sub>2</sub> 中性点连接控制开关及其投入控制开关,并关断故 障相中性点连接控制开关,将RM,投入故障相运行。

在双子模块投入运行状态下,如果PET再次发 生子模块故障,则由控制及保护系统发出停机指令, 隔离故障PET。

2)容错运行策略。

PET 容错运行策略如附录 A 图 A5 所示。在不同的工作模式下,将冗余子模块测量信号通过不同通道输入 PET 的控制与保护系统,由 PET 控制系统对其运行状态进行统一调节。同时,根据故障定位结果和冗余结构运行状态,结合控制系统给出的基本载波和调制波信号,确定冗余子模块的载波和调制波,产生 HB 触发脉冲,实现冗余子模块与正常子模块的协调配合运行。

CHB型PET一般采用载波移相调制,同一相的 子模块载波依次移相 $\pi/N$ ,然后与调制波比较得到 子模块触发脉冲。根据PET故障定位结果,冗余子 模块在基本载波基础上的移相值 $\Delta \phi_c$ 为:

$$\Delta \phi_{\rm c} = (p-1)\pi/N \tag{2}$$

式中: p=1,2,…,N,表示故障子模块位置。

根据故障子模块所在相的检测结果,冗余子模 块的调制波为:

$$u_{r1} = k_{r1} u_{r\varphi}, \ u_{r2} = k_{r2} u_{r\varphi} \tag{3}$$

式中: $u_{r1}$ 和 $u_{r2}$ 分别为 RM<sub>1</sub>和 RM<sub>2</sub>的调制波; $k_{r1}$ 和 $k_{r2}$ 分 别为 RM<sub>1</sub>和 RM<sub>2</sub>的调制波系数; $u_{re}(\varphi=a,b,c)$ 为冗余 结构投入相的调制波信号。 $k_{r1}$ , $k_{r2} \in \{1,0,-1\}$ ,正常 运行时,取值为0。对于 $k_{r1}$ ,在o<sub>1</sub>做中性点的状态下, 取值为1;在o<sub>2</sub>做后备中性点的状态下,取值为-1,对 调制波做反相处理。对于 $k_{r2}$ ,在o<sub>1</sub>或o<sub>2</sub>做中性点的 状态下,取值为1;在o<sub>3</sub>做后备中性点的状态下,取值 为-1,对调制波做反相处理。

#### 3 可靠性及成本分析

良好的冗余结构设计需要兼顾设备运行可靠性和经济性的要求。本节根据采用冗余结构的PET的运行特点,从一般性角度,给出了其可靠性和制造成本的评估计算方法。以此为基础,对所提出的冗余结构设计方案的可靠性和经济性进行了分析,并与其他采用不同冗余结构的PET进行了对比,以验证所提方案的合理性。

3.1 PET可靠性及成本分析

设备可靠性一般按式(4)进行计算。

$$R(t) = e^{-\lambda t} \tag{4}$$

式中: λ 为设备故障率; t 为运行时间。

图2所示的PET子模块可靠性 $R_{sm}$ 为:

$$R_{\rm sm} = R_{\rm ight}^{12} R_{\rm c}^2 R_{\rm hft} \tag{5}$$

式中: R<sub>ight</sub>、 R<sub>e</sub>和 R<sub>hf</sub>分别为 IGBT 单元、电容和高频变 压器的可靠性。

对于冗余系统,通常采用k/n(G)模型进行可靠 性分析,具体为<sup>[20]</sup>:

$$R = \sum_{i=0}^{k} C_{w}^{i} R_{sm}^{w-i} (1 - R_{sm})^{i}$$
(6)

式中:w为系统子模块数;k为系统维持运行所允许的最多故障子模块数;i为故障子模块数。

在式(4)一(6)的基础上,对本文提出的双子模 块公共冗余结构可靠性进行评估。具备该结构的 PET包含无子模块故障、单子模块故障和双子模块 故障状态这3种运行状态。

无子模块故障状态下,PET可靠性为:

$$R_{1} = R_{\rm sm}^{3N} \left[ 1 - (1 - R_{\rm bs}^{3})^{3} \right]$$
(7)

单子模块故障状态下,PET可靠性为:

$$R_{2} = C_{3N}^{1} (1 - R_{sm}) R_{sm}^{3N-1} R_{bp} \left\{ R_{sm} \left[ 1 - (1 - R_{bs}^{3})^{2} \right] + \right.$$

$$(1 - R_{\rm sm}) R_{\rm sm} \left[ 1 - (1 - R_{\rm bs}^4)^3 \right]$$
(8)

双子模块故障状态下,其可靠性为:

$$R_{3} = C_{3N}^{2} (1 - R_{sm})^{2} R_{sm}^{3N-2} R_{bp}^{2} R_{sm}^{2} \left[ 1 - (1 - R_{bs}^{4})^{2} \right] \quad (9)$$

式中:R<sub>bo</sub>和R<sub>bs</sub>分别为旁路开关和BS的可靠性。

在可靠性计算过程中(式(7)--(9))考虑了2.2 节所提的状态切换开关组的后备功能。综上,图4 所示的双子模块公共冗余型PET的可靠性为:

$$R = R_1 + R_2 + R_3 \tag{10}$$

图4所示的双子模块公共冗余型PET一次设备制造总成本为:

$$C = (3N+2)C_{\rm sm} + 3NC_{\rm hp} + 11C_{\rm hs}$$
(11)

式中: C<sub>sm</sub>、C<sub>bp</sub>和 C<sub>bs</sub>分别为子模块、旁路开关和 BS的成本。

子模块成本为:

$$C_{\rm sm} = 12C_{\rm ight} + 2C_{\rm c} + C_{\rm hft}$$
 (12)

式中: C<sub>ight</sub>、C<sub>e</sub>和 C<sub>hft</sub>分别为 IGBT 单元、电容和高频变压器成本。

PET主要元件的故障率及成本数据见附录A表A2。表中,IGBT和电容故障率为实际统计数据<sup>[21]</sup>;高频变压器故障率参考同电压等级PET<sup>[22]</sup>;旁路开关一般选用高可靠性开关,文献[21]按理想开关处理,本文以略低于IGBT单元的原则对旁路开关的故障率进行合理假设。元件成本按照工程经验选取。

BS故障率取决于开关类型,可以根据运行可靠

性及成本方面的不同需求,选用不同结构的BS。部分BS结构如图5所示。



#### Fig.5 Topologies of BS

图 5(a)、(b)中 BS采用全控器件构成,控制方 便,切换速度快。图 5(c)中 BS成本较低,且具有良 好的可靠性,但只能在电流过零点时自然关断,切换 速度和灵活性难以满足应用要求。相较而言,虽然 图 5(b)所示的 BS的开通损耗较小,但其可靠性有所 降低,且成本较高。本文综合考虑控制灵活性、制造 成本和运行可靠性,选用图 5(a)所示的 BS作为冗余 结构的切换开关,并以此进行可靠性和成本分析。 鉴于二极管运行可靠性远高于IGBT,以略高于IGBT 单元的原则对图 5(a)所示的 BS的故障率进行合理 假设。

#### 3.2 不同冗余结构下的PET性能对比

在3.1节的基础上,将附录A表A2中的参数代 入式(7)—(12),对双子模块公共冗余型PET的可靠 性及成本进行评估。同时,对已有不同冗余结构以 相同的计算原则和参数进行可靠性和成本分析,用 于性能对比。所分析的结构如下:结构I为双子模 块公共冗余结构,即本文所提出的结构;结构II为无 冗余结构<sup>[15]</sup>;结构II为单子模块公共冗余结构<sup>[12]</sup>; 结构IV为单子模块分相冗余结构<sup>[10]</sup>;结构V为双子 模块冗余结构<sup>[14]</sup>;结构VI为双子模块分相冗余结构。 以上6种结构的可靠性分析结果如图6所示。



different structures

采用不同结构的PET的成本计算结果与投入运行第1年的可靠性如表1所示,表中还展示了PET的容量、级联子模块数N以及各冗余结构下的冗余子模块数N<sub>r</sub>。需要说明的是,各冗余结构下的可靠性及成本分析结果是针对不同的冗余设计方法,基于相同的PET主电路和容量,通过统一的计算原则和数据得到的。因此,能够反映不同冗余结构的性能

相对关系,基本不受具体数据的影响。

表1 采用不同结构的PET可靠性及成本评估

Table 1 Reliability and cost estimation of PET

with different structures

结构	PET 额定容量 / (MV・A)	Ν	$N_{ m r}$	第1年可靠 性/%	成本 / 万元
Ι	1.5	5	2	99.63	100.386
Ш	1.5	5	0	75.59	84.870
Ш	1.5	5	1	96.24	93.228
IV	1.5	5	3	98.37	102.924
V	1.5	5	2	99.49	102.066
VI	1.5	5	6	99.04	120.078

由图6可见,采用结构Ⅱ和结构Ⅲ的PET可靠 性远低于其他结构,不能满足工程应用需求。本文 提出的双子模块公共冗余结构(结构 I)在设备投运 初期可靠性最高,长期运行过程中,其可靠性仅次于 结构 VI, 但差别不大。由表1 可见, 结构 VI 成本远高 于其他结构,因此其性价比远低于结构Ⅱ之外的其 他结构,工程实用性较差。结构 [ 成本略高于结构 Ⅱ和结构Ⅲ,但是能够大幅提升PET运行可靠性。 结构 V 性能指标略逊于结构 I。但需要指出的是,与 结构 V 相比,结构 I 中冗余子模块结构与 PET 主电 路的子模块结构相同,其触发控制系统、散热装置、 机械结构等均可直接沿用主电路子模块的设计方 案。结构V中的冗余子模块与主电路子模块结构不 同,其触发控制系统、散热装置、机械结构等均需要 在主电路子模块基础上进行相应的改动,且不利于 检修和故障更换。此外,结构 I 因采用与主电路子 模块相同的结构,可拓展性强,模式切换控制简单。 结构V的切换逻辑以及冗余子模块的控制复杂度会 随着冗余子模块数量的增加而增加。综上,本文提 出的双子模块公共冗余结构能够在控制成本的前提 下,有效提升PET的可靠性,较好满足工程应用要求。

#### 4 仿真验证

在 PSCAD / EMTDC 软件中搭建 PET 及冗余结构的详细模型,对冗余结构功能及容错控制策略的有效性进行测试。仿真系统关键参数如附录 A 表 A3 所示。在仿真测试中,分别考虑定功率和定电压控制模式,以及不同负载水平和外部故障等条件,针对单子模块故障、同相和异相双子模块故障等故障类型进行了测试,以全面分析本文所提出的冗余结构和容错控制策略。

#### 4.1 单子模块故障

PET运行于定功率整流工况,传输功率为额定 功率。SM<sub>a2</sub>在0.2 s时发生开路故障。故障前后的 子模块电压如图7所示,图中u<sub>sma2</sub>、u<sub>m1</sub>和u<sub>m2</sub>分别 为故障子模块SM<sub>a2</sub>电压、RM<sub>1</sub>和RM<sub>2</sub>电压,且均为标 幺值。由图7可见,单子模块故障下,采用冗余结构的PET能够迅速切换至单子模块投入模式,以RM<sub>1</sub>替换故障子模块,从而保证整体系统稳定可靠运行。



图7 额定负载单子模块故障下的子模块电压

Fig.7 Voltage of SM under single-SM fault in rated load condition

故障子模块及冗余子模块的端口电压及电流如 图8所示,图中u<sub>a2</sub>、i<sub>a2</sub>和u<sub>mol</sub>、i<sub>ml</sub>分别为故障子模块和 RM<sub>1</sub>的端口电压、电流,且均为标幺值。故障发生 前,故障子模块投入主电路运行,端口电压为正弦脉 宽调制波,电流为桥臂电流,RM<sub>1</sub>运行于旁路状态, 端口电压及电流均为0。故障发生后,故障子模块 运行于旁路状态,RM<sub>1</sub>投入主回路替代故障子模块。 冗余结构下的模式切换过程平滑迅速,不会产生剧 烈的暂态冲击。





设初始工况与上文一致,在0.15 s时,BC两相电 压跌落至额定值的40%,PET进入低电压穿越状态。 在0.2 s时,SM<sub>a2</sub>发生短路故障。附录A图A6给出了 冗余结构下PET在低电压穿越运行期间的工作情 况。由图可见,子模块发生短路故障后电压跌落,冗 余结构迅速投入子模块RM<sub>1</sub>。RM<sub>2</sub>仍处于备用状 态。容错控制系统在PET低电压穿越期间能够可靠 工作,冗余结构模式切换对整体运行性能基本不会 造成影响。

#### 4.2 同相双子模块故障

PET运行于定电压整流额定负载工况。在0.2 s 和 0.3 s 时, SM<sub>a2</sub>和 SM<sub>a4</sub>内部分别发生开路故障(故 障 1)和短路故障(故障 2)。图 9为无冗余条件下的 直流电压 u<sub>d</sub>和交流电流 i<sub>abc</sub>波形,图中电压和电流均 为标幺值。由图可见,子模块内部发生故障时,将严 重影响 PET运行性能,双子模块故障情况下运行性 能进一步劣化,定电压控制模式下直流母线电压产 生波动,影响电能质量。交流侧电流发生严重畸变 和过流,威胁 PET安全,对电力系统造成谐波污染。



采用本文所提出的新型双子模块公共冗余结构,在容错控制策略调节下,同相双子模块故障情况下的直流电压、交流电流和子模块电压波形如图10所示,图中u<sub>smat</sub>为SM<sub>at</sub>电压,且图中电压和电流均为标幺值。故障子模块及冗余子模块的端口电压和电流波形如附录A图A7所示。





由图 10 和图 A7 可见, SM<sub>a2</sub>发生开路故障时, 控 制系统旁路故障子模块并投入 RM<sub>1</sub>, 由正常模式切 换至单子模块投入模式。该情况下, SM<sub>a4</sub>发生短路 故障时, RM<sub>2</sub>快速投入, 由单子模块投入模式切换至 同相双子模块串联投入模式。在冗余结构运行模式 切换过程中, 冗余子模块能够迅速替代故障子模块 运行, 不会产生严重的暂态冲击, 对 PET 整体运行性 能基本不会造成影响。切换完成后, PET 能够实现 稳定可靠运行。 PET运行于定功率逆变状态,传递功率为额定 功率,在0.2 s和0.3 s时,SM<sub>a2</sub>和SM<sub>b5</sub>分别发生短路 和开路故障。附录A图A8为无冗余条件下的功率 和交流电流波形。由图可见,发生异相双子模块故 障时,也会对PET的运行性能造成较大影响。此时, 故障相的级联子模块数减小,由于子模块电压被公 共直流母线电压箝位在额定电压附近,PET输出的 多电平电压无法达到预定值。因此,交流侧电流将 发生畸变和过流,进而导致有功功率及无功功率产 生大幅波动。

异相双子模块故障下,具备冗余结构的PET功 率、交流电流和子模块电压如附录A图A9所示。故 障子模块及冗余子模块的端口电压和电流波形如附 录A图A10所示。由图A9和图A10可见,SM\_a2发生 短路故障时,电压发生严重跌落,控制系统将RM\_投 入A相运行,冗余结构由正常模式切换至单子模块 投入模式。该情况下,SM\_b5发生开路故障时,在逆变 状态下其子模块电压逐渐跌落,由控制系统将RM\_ 投入B相运行,冗余结构由单子模块投入模式切换 至双子模块分相投入模式。这与图10所示效果相 同,可见采用冗余结构及相应容错控制策略能够提 高PET在子模块故障期间的可靠性,维持其整体运 行性能。

#### 5 结论

本文针对 CHB 型 PET 提出一种双子模块公共 冗余结构和容错控制策略,并与其他冗余结构的可 靠性和制造成本进行对比分析,得到如下主要结论。

1)与分相冗余结构相比,公共冗余结构能够降低成本,减小设备体积和重量,并提高冗余模块利用率。与单子模块冗余结构相比,双子模块冗余结构功能丰富,可以实现任意单子模块和双子模块故障备用,增强PET容错能力。

2)容错控制策略实现方便,可以根据故障情况 进行冗余结构运行模式的灵活切换,在PET定电压 和定功率等不同控制模式以及正常运行和电网故障 等多种工况下均能有效实现备用功能。仿真结果验 证了其具有良好的性能。

3)可靠性和成本分析结果表明相较于采用其他 冗余结构的PET,本文所提出的设计方案可较好兼 顾可靠性和经济性要求,更好满足工程应用要求。

本文所提出的冗余结构设计原则具有较强的可 拓展性,适用于任意数目冗余子模块的应用场合。 此外,该冗余方案和控制策略除能用于PET外,也能 为采用CHB结构的有源滤波器、静止同步补偿器等 电力电子设备在冗余结构设计和容错控制方面提供 参考。

#### 附录见本刊网络版(http://www.epae.cn)。

#### 参考文献:

 [1]张凡,高红均,李海波,等.基于一致性耦合关联的交直流混合 配电网协调能量管控[J].电力自动化设备,2020,40(10):23-29,116.
 ZHANG Fan,GAO Hongjun,LI Haibo,et al. Energy coordinated

management of AC / DC hybrid distribution network based on consistent coupling association [J]. Electric Power Automation Equipment, 2020, 40(10): 23-29, 116.

- [2]黄堃,郝思鹏,宋刚,等.含三端口电力电子变压器的交直流混 合微网分层优化[J].电力自动化设备,2020,40(3):37-43.
   HUANG Kun, HAO Sipeng, SONG Gang, et al. Layered optimization of AC/DC hybrid microgrid with three-port power electronic transformer[J]. Electric Power Automation Equipment,2020,40(3):37-43.
- [3]梁得亮,柳铁彬,寇鹏,等. 智能配电变压器发展趋势分析[J].
   电力系统自动化,2020,44(7):1-14.
   LIANG Deliang,LIU Yibin,KOU Peng, et al. Analysis of development trend for intelligent distribution transformer[J]. Automation of Electric Power Systems,2020,44(7):1-14.
- [4] 刘科研,盛万兴,赵鹏杰,等.信息物理环境下基于电力电子变 压器的跨台区光伏消纳策略[J].电力自动化设备,2020,40(12): 66-72,87.
   LIU Keyan, SHENG Wanxing, ZHAO Pengjie, et al. Photovoltaic consumption strategy across multiple transformer districts

based on PET under cyber physical system [J]. Electric Power Automation Equipment, 2020, 40(12):66-72, 87.

- [5] 李彬彬,张玉洁,张书鑫,等. 具备故障阻断能力的柔性直流输电DC/DC变换器[J]. 电力系统自动化,2020,44(5):53-59.
   LI Binbin,ZHANG Yujie,ZHANG Shuxin, et al. DC/DC converter with fault blocking capability for HVDC transmission system[J]. Automation of Electric Power Systems,2020,44(5): 53-59.
- [6] ALEENEJAD M, JAFARISHIADEH S, MAHMOUDI H, et al. Reduced number of auxiliary H-bridge power cells for postfault operation of three phase cascaded H-bridge inverter[J]. IET Power Electronics, 2019, 12(11):2923-2931.
- [7] BRIZ F,LOPEZ M,RODRIGUEZ A,et al. Modular power electronic transformers:modular multilevel converter versus cascaded H-bridge solutions [J]. IEEE Industrial Electronics Magazine, 2016,10(4):6-19.
- [8] 薛英林,徐政,张哲任,等.子模块故障下C-MMC型高压直流 系统的保护设计和容错控制[J].电力自动化设备,2014,34(8): 89-97.

XUE Yinglin, XU Zheng, ZHANG Zheren, et al. Protection design and fault-tolerant control of C-MMC based HVDC system under sub-module failure condition [J]. Electric Power Automation Equipment, 2014, 34(8):89-97.

- [9] NEYSHABOURI Y,IMAN-EINI H. A new fault-tolerant strategy for a cascaded H-bridge based STATCOM[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2018, 65(8):6436-6445.
- [10] SUN L, WU Z X, XIAO F, et al. Suppression of real power back flow of nonregenerative cascaded H-bridge inverters operating under faulty conditions [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2016, 31(7):5161-5175.
- [11] LIU J Q,ZHAO N. Improved fault-tolerant method and control strategy based on reverse charging for the power electronic traction transformer[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2018, 65(3): 2672-2682.
- [12] 桑子夏,郑旭,颜炯,等. 基于级联多电平变换器的固态变压器 冗余设计的容错控制研究[J]. 电源学报,2019,17(5):31-38.

SANG Zixia, ZHENG Xu, YAN Jiong, et al. Research on redundancy design for fault-tolerant control of solid-state transformer based on cascaded multi-level converter[J]. Journal of Power Supply, 2019, 17(5): 31-38.

- [13] 汪玉凤,张影,李爽,等. 多电平级联日桥逆变器 3N+1 冗余容 错策略的研究[J]. 高压电器,2018,54(2):208-212.
  WANG Yufeng, ZHANG Ying, LI Shuang, et al. Research on 3N+1 redundancy fault-tolerance strategy of multilevel cascaded H-bridge inverter[J]. High Voltage Apparatus, 2018, 54(2): 208-212.
- [14] TIAN J, MAO C X, WANG D, et al. A short-time transition and cost saving redundancy scheme for medium-voltage threephase cascaded H-bridge electronic power transformer[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2018, 33(11):9242-9252.
- [15] 刘闯,支月媚. 混合级联式电力电子变压器拓扑结构及控制策略[J]. 电网技术,2017,41(2):596-603.
   LIU Chuang,ZHI Yuemei. Hybrid cascaded power electronics transformer topology and control scheme[J]. Power System Technology,2017,41(2):596-603.
- [16] 李俊杰,吕振宇,吴在军,等.基于电力电子变压器的交直流混 合微电网运行模式自适应切换策略[J].电力自动化设备,2020, 40(10):126-131,138.

LI Junjie, LÜ Zhenyu, WU Zaijun, et al. Adaptive switching strategy of AC / DC hybrid microgrid operating mode based on power electronic transformer[J]. Electric Power Automation Equipment, 2020, 40(10): 126-131, 138.

[17] 周念成,苏宇,王强钢,等.基于IGBT的配电变压器有载调 压开关参数设计及分析[J].电力自动化设备,2018,38(7):35-42,67.

ZHOU Niancheng, SU Yu, WANG Qianggang, et al. Parameter design and analysis of IGBT-based on-load tap changers for distribution transformer[J]. Electric Power Automation Equipment, 2018, 38(7); 35-42, 67.

[18] 韩杰祥,张哲,尹项根,等.级联型电力电子变压器内部开路故 障特征及定位方法研究[J].中国电机工程学报,2020,40(19): 6071-6084.

HAN Jiexiang, ZHANG Zhe, YIN Xianggen, et al. Research on fault characteristic and location method for internal open circuit fault of cascaded power electronic transformer[J]. Proceedings of the CSEE, 2020, 40(19):6071-6084.

- [19] LAMB J, MIRAFZAL B. Open-circuit IGBT fault detection and location isolation for cascaded multilevel converters [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2017, 64(6):4846-4856.
- [20] RADWAN T, ALRAWASHDEH M J, GHANEM S. An efficient formula for generalized multi-state k-out-of-n: G system reliability[J]. IEEE Access, 2019, 7:44823-44830.
- [21] GRINBERG R, RIEDEL G, KORN A, et al. On reliability of medium voltage multilevel converters[C]//5th IEEE Energy Conversion Congress and Exposition. Denver, USA: IEEE, 2013: 4047-4052.
- [22] XU X X, TAI N L, HU Y, et al. Reliability calculation of AC/DC hybrid distribution network with a solid-state transformer[J]. The Journal of Engineering, 2019(16):3067-3071.

#### 作者简介:



韩杰祥(1995—),男,博士研究生,主 要研究方向为交直流混合配电网控制及保 护技术(E-mail: jiexianghan@163.com); 张 诏(1962—),男,教授,博士研究

生导师,主要研究方向为电力系统继电保护 与控制(E-mail:zz\_mail2002@163.com);

徐可寒(1995—),男,博士研究生,主 要研究方向为电力系统继电保护与控制

韩杰祥

(**E-mail**:d201880430@hust.edu.cn); 尹项根(1954—),男,教授,博士研究生导师,主要研

究方向为电力系统继电保护与控制(E-mail: xgyin@mail. hust.edu.cn)。

(编辑 李玮)

# Communal redundant structure and fault-tolerant control strategy for power electronic transformer

HAN Jiexiang, ZHANG Zhe, XU Kehan, YIN Xianggen

(State Key Laboratory of Advanced Electromagnetic Engineering and Technology,

Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China)

**Abstract**: PET(Power Electronic Transformer) contains many power electronic devices, the failure rate of its submodules is relatively high, which seriously affects the reliability of power supply. To improve the reliability and fault-tolerant ability of cascaded H-bridge PET, combining with the structural and operating characteristics of cascaded H-bridge, a dual-submodule communal redundant structure is proposed. This structure switches the connection mode between the two redundant submodules flexibly through bidirectional switches, and can realize the standby function in the case of any single- or dual-submodule fault inside PET. Based on the novel redundant structure, the fault-tolerant control strategy and mode switching logic of the redundant structure are proposed, and the operating reliability and manufacturing cost of PET with different redundant structures are compared.

Key words: power electronic transformer; cascaded H-bridge; redundant structure; fault-tolerant control; reliability

106



Fig.A1 Topology of multiple submodule redundant structure

Tal	Table A1 Mode switching example of redundant structure											
Da	模式1				模式2				模式3		模式4	
BS	$S_1$	$\mathbf{S}_2$	$S_3$	$S_4$	$S_5$	$\mathbf{S}_{6}$	$\mathbf{S}_7$	$S_8$	S9	${\bf S}_{10}$	S <sub>11</sub>	<b>S</b> <sub>12</sub>
$G_{ao}$	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
$G_{bo}$	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
$G_{co}$	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0
$G_{al}$	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0
$G_{bl}$	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
$G_{cl}$	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
$G_{a2}$	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
$G_{b2}$	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1
$G_{c2}$	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0
$G_{12}$	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
$G_{2o}$	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0

	表A	1 ]	冗余结构	<b>月模式</b> 地	刀拚	际	列		
 		• .			c				



Fig.A2 Operation state diagram of redundant structure











### 图 A5 PET 容错运行策略

Fig.A5 PET fault-tolerant operation strategy

表 A2 PET 主要元件故障率及成本数据

Table A2 Failure rate and cost data of PET componen	ts
---	----

元件	故	成木/元	V./kV	其他参数
	HXI++/()( u )	/*x/+*//U	• <sub>N</sub> / K •	
IGBT 单元	0.000876	4200	3.3	额定电流为 200 A
稳压电容	0.001752	90	3	电容值为 3000 μF
高频变压器	0.004643	6000	1.9/0.75	额定容量为 0.25 kV·A
旁路开关	0.0006	600	3.3	额定电流为200A
BS	0.0012	3000	3.3	额定电流为 200 A

Table A3 Simulation system parameters						
仿真参数	数值	仿真参数	数值			
PET 额定容量/(MV·A)	1.5	PET 额定 AC 电压/kV	10			
PET 额定 DC 电压/V	750	PET 桥臂滤波电感/H	0.02			
每桥臂子模块级联数 N	5	HB 稳压电容/µF	3000			
高频变压器变比	2.53	DAB 输出电容/µF	4000			

表 A3 仿真系统参数





Fig.A6 Redundant module function under low voltage ride through operating conditions



Fig.A7 Voltage and current of SM port under dual-submodule fault in same phase



Fig.A8 Dual-submodule fault in different phases without redundancy







Fig.A10 Voltage and current of SM port under dual-submodule fault in different phases